

半 导 体 学 报

第 3 卷 第 3 期 1982 年 5 月

目 录

高纯度砷化镓残留受主 BA、DA 峰的电子声子耦合	
.....陈廷杰 吴灵犀 徐寿定 孟庆惠 于 鲲 李永康 (169)	
GaAs-AlGaAs 异质结界面及开关现象的研究	
.....林世鸣 王启明 杜宝勋 石忠诚 高季林 (175)	
p/p ⁺ Pb _{0.8} Sn _{0.2} Te 液相外延层等离子体的红外反射光谱	
.....冷 静 杨永年 袁诗鑫 (182)	
由 MOS 结构对线性电压扫描的瞬态响应测定产生寿命和表面产生速度	
.....张秀森 包宗明 苏九令 (192)	
GD非晶硅中氧、氮对其光电特性的影响	
.....徐温元 孙钟林 王宗畔 李德林 (197)	
偏离〈111〉晶向的硅表面层中氧化层错的研究	
.....鲍希茂 嵇福权 黄信凡 (202)	
绝缘边界对扩展电阻测量的影响	
.....陈存礼 (208)	
电化学 C-V 法测量半导体材料载流子浓度分布	
.....邵永富 陈自姚 彭瑞伍 (215)	
GaAs MES FET 单片集成电路工艺研究	
.....王立模 罗浩平 李其忠 杨凤臣 江 锋 瞿志仁 陈凌云 马洪芳 (222)	

研 究 简 报

复合型 GaAs 材料在 10.6 μ m 吸收特性的研究	
.....王桂芬 张光寅 张春平 (230)	
磷化铟与氧化膜界面物理性质的研究	
.....陈克铭 仇兰华 崔玉德 陈维德 简萍清 (233)	
SOS 外延膜的光吸收研究	
.....章熙康 顾隆道 (238)	
用 DLTS 研究中子嬗变掺杂硅中的电子陷阱	
.....吴书祥 晏懋洵 杜光庭 孟祥提 (241)	
不同金属栅极的 M-SiO ₂ -Si 系统可动离子界面陷阱能量分布的研究	
.....王阳元 张利春 吉力久 倪学文 (245)	
用背散射和沟道技术分析异质外延硅层的缺陷	
.....承焕生 徐志伟 赵国庆 周筑颖 (248)	
用 DLTS 研究注氧硅中深中心缺陷	
.....张玉峰 张丽珠 吴书祥 杜永昌 (251)	

会 议 简 讯

第三届全国半导体物理会议	(255)
第二届《全国集成电路和硅材料学术年会》	(255)
第四届全国砷化镓及有关化合物学术交流会议	(256)
全国中、大规模集成电路设计及分析学术会议	(256)
1981 年国际砷化镓和有关化合物学术会议	(257)